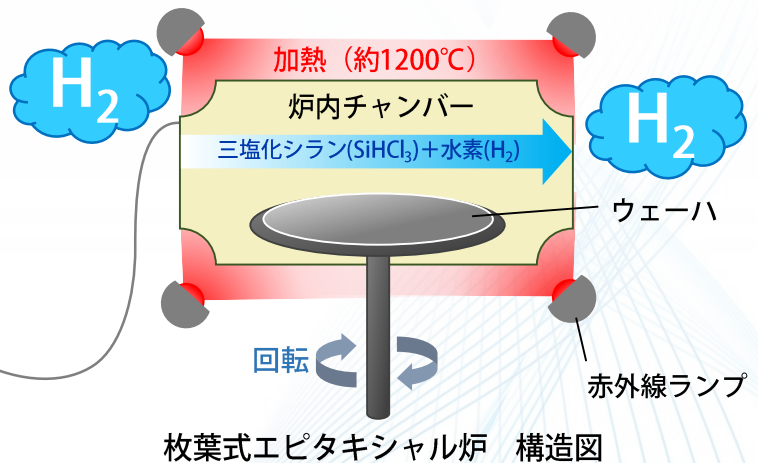


# シリコンウェーハ製造工程中の 水素濃度管理に

水素の供給濃度を  
監視することにより、  
ウェーハの  
品質を一定に！



光波干渉式ガスモニター  
Model :  
**FI-8000**



半導体シリコンウェーハの製造工程では、ポリッシュト・ウェーハ※の表面に気相成長（エピタキシャル成長）させた単結晶シリコン膜の層を形成することで、さらに優れた品質のエピタキシャル・ウェーハを製造することがあります。

気相成長では、約1200℃まで加熱した炉内に三塩化シラン（トリクロルシラン、 $\text{SiHCl}_3$ ）と水素（ $\text{H}_2$ ）を流すことで、単結晶シリコンの膜を形成します。供給する $\text{H}_2$ の濃度管理として、光波干渉式ガスモニター FI-8000をご提案いたします。

FI-8000で炉内へ導入する $\text{H}_2$ のガス濃度を監視し、一定の濃度の $\text{H}_2$ を供給することにより、欠陥品の防止につながり、一定の品質に保たれたウェーハの製造を行うことができます。

※ シリコンウェーハの材料となる単結晶インゴットをスライスして表面を鏡面研磨したウェーハ

## 理研計器株式会社

【営業本部】  
〒174-8744  
東京都板橋区小豆沢2-7-6  
TEL: 03-3966-1111

詳しい内容はお近くの営業所まで  
<https://www.rikenkeiki.co.jp/>